

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректор по учебной работе

Дата подписания: 27.10.2023 12:14:45

Уникальный идентификатор документа:

d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Методы исследования материалов

Закреплена за подразделением

Кафедра физического материаловедения

Направление подготовки

22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

Профиль

Квалификация **Инженер-исследователь**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 252

в том числе:

аудиторные занятия 136

самостоятельная работа 80

часов на контроль 36

Формы контроля в семестрах:

экзамен 5

зачет с оценкой 6

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	5 (3.1)		6 (3.2)		Итого	
	УП	РП	УП	РП		
Неделя	19		18			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Лекции	34	34	34	34	68	68
Лабораторные	34	34	34	34	68	68
Итого ауд.	68	68	68	68	136	136
Контактная работа	68	68	68	68	136	136
Сам. работа	40	40	40	40	80	80
Часы на контроль	36	36			36	36
Итого	144	144	108	108	252	252

Программу составил(и):

старший преподаватель, Захарова Елена Александровна; ктн, доцент, Новиков Александр Ильич

Рабочая программа

Методы исследования материалов

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» по направлению подготовки 22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ (приказ от 28.06.2023 г. № 292 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ, 22.03.01-БМТМ-23_6-ПП.plx , утвержденного Ученым советом НИТУ МИСИС в составе соответствующей ОПОП ВО 22.06.2023, протокол № 5-23

Утверждена в составе ОПОП ВО:

22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ, , утвержденной Ученым советом НИТУ МИСИС 22.06.2023, протокол № 5-23

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра физического материаловедения

Протокол от 29.06.2023 г., №11-06

Руководитель подразделения Савченко Александр Григорьевич

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1	Сформировать компетенции в соответствии с требованиями учебного плана, а также научить основам современных дифракционных и микроскопических методов исследования материалов, пониманию возможностей этих методов, их точности, чувствительности, локальности и применимости с целью изучения связи между составом, структурой и свойствами и контроля качества материалов и технологических процессов их производства
-----	---

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП:		Б1.В.ДВ.05
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Введение в квантовую механику	
2.1.2	Кристаллография	
2.1.3	Методы математической физики	
2.1.4	Физическая химия	
2.1.5	Информатика	
2.1.6	Математика	
2.1.7	Химия	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Атомное строение фаз	
2.2.2	Биохимия наноматериалов	
2.2.3	Инженерия поверхности	
2.2.4	Компьютерная металлография	
2.2.5	Металловедение и термическая обработка металлов	
2.2.6	Методы исследования структур и материалов. Часть 1	
2.2.7	Методы исследования физических свойств полупроводниковых структур	
2.2.8	Методы физико-химических исследований	
2.2.9	Наноматериалы	
2.2.10	Научно-исследовательская работа	
2.2.11	Научно-исследовательская работа	
2.2.12	Научно-исследовательская работа	
2.2.13	Научно-исследовательская работа	
2.2.14	Основы физики поверхности	
2.2.15	Сверхтвердые материалы	
2.2.16	Современные методы получения наночастиц и наноматериалов	
2.2.17	Технологии материалов с особыми физическими свойствами	
2.2.18	Фазовые и структурные изменения при формировании материалов и эпитаксиальных структур	
2.2.19	Физика магнитных явлений	
2.2.20	Физика полупроводниковых приборов	
2.2.21	Физика прочности	
2.2.22	Физика прочности и механические свойства материалов	
2.2.23	Физико-химия металлов и неметаллических материалов	
2.2.24	Физические основы деформации и разрушения	
2.2.25	Атомная и электронная структура поверхности и межфазных границ	
2.2.26	Композиционные материалы	
2.2.27	Конструирование композиционных материалов	
2.2.28	Методы исследования структур и материалов. Часть 2	
2.2.29	Поверхностное модифицирование материалов и защитные покрытия	
2.2.30	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	
2.2.31	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	
2.2.32	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	
2.2.33	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	
2.2.34	Специальные сплавы	
2.2.35	Физическое материаловедение сплавов с особыми магнитными свойствами, часть 1. Магнитно-мягкие сплавы	

2.2.36	Физическое материаловедение сплавов с особыми магнитными свойствами, часть 2. Магнитно-твердые сплавы
2.2.37	Аморфные, микро- и нанокристаллические материалы
2.2.38	Биофизика
2.2.39	Высокотемпературные и сверхтвердые функциональные и конструкционные материалы
2.2.40	Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве
2.2.41	Материаловедение и технологии перспективных материалов
2.2.42	Методы исследования характеристик и свойств материалов
2.2.43	Методы электронной микроскопии для материалов твердотельной электроники
2.2.44	Метрология и испытания функциональных материалов
2.2.45	Основы научно-технического перевода
2.2.46	Практика научно-технического перевода и редактирования
2.2.47	Тензорные методы в кристаллофизике
2.2.48	Технология получения кристаллов
2.2.49	Физические основы магнетизма и процессы перемагничивания материалов
2.2.50	Физические свойства приповерхностных слоев и методы их исследований
2.2.51	Функциональные наноматериалы
2.2.52	Химия и технология полимерных материалов
2.2.53	Бионаномедицина
2.2.54	Биоорганическая химия
2.2.55	Высокотемпературные керамические материалы
2.2.56	Жаропрочные и радиационно-стойкие материалы
2.2.57	Квантовая теория твердого тела
2.2.58	Математическое и компьютерное моделирование материалов и процессов
2.2.59	Математическое и компьютерное моделирование материалов и процессов электроники
2.2.60	Методы исследования макро- и микроструктуры материалов
2.2.61	Методы непараметрической статистики
2.2.62	Некоторые главы кристаллохимии
2.2.63	Объемные наноматериалы
2.2.64	Оптические явления в кристаллах. Часть 1
2.2.65	Процессы получения и обработки сверхтвердых материалов
2.2.66	Современные конструкционные материалы
2.2.67	Спектроскопические методы анализа поверхности
2.2.68	Структура и технологичность сплавов
2.2.69	Физико-химия получения и обработки материалов
2.2.70	Физико-химия эволюции твердого вещества
2.2.71	Физические свойства и функциональные явления в наноматериалах
2.2.72	Ядерно-спектроскопические и синхротронные методы исследований
2.2.73	Аттестация и испытания высокотемпературных и сверхтвердых материалов
2.2.74	Аттестация и сертификация изделий электронной техники
2.2.75	Инновационные конструкционные материалы для медицины
2.2.76	Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве функциональных материалов
2.2.77	Материаловедение и технологии перспективных материалов
2.2.78	Материалы и элементы спинтроники и спинволновой оптики
2.2.79	Менеджмент качества
2.2.80	Металлические материалы для крупных транспортных систем
2.2.81	Металловедение высокопрочных сплавов
2.2.82	Методология и практика определения размерных характеристик материалов
2.2.83	Методология научных исследований
2.2.84	Оптические явления в кристаллах. Часть 2
2.2.85	Основы клеточной биологии
2.2.86	Оформление результатов научной деятельности
2.2.87	Порошковая металлургия высокотемпературных и сверхтвердых материалов
2.2.88	Практическое применение методов анализа Big data

2.2.89	Практическое применение теории функционала электронной плотности
2.2.90	Применение лазерных систем
2.2.91	Симметрия наносистем
2.2.92	Современные компьютерные технологии в структурном анализе
2.2.93	Современные материалы медицинского назначения
2.2.94	Спектроскопические и зондовые методы
2.2.95	Термомеханическая обработка металлов и сплавов
2.2.96	Управление коллективами
2.2.97	Управление проектами
2.2.98	Физические методы исследования материалов
2.2.99	Химические основы биологических процессов
2.2.100	Цифровая электроника
2.2.101	Цифровое материаловедение
2.2.102	Нормы и правила оформления ВКР
2.2.103	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.104	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.105	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.106	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.107	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.108	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.109	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.110	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.111	Физико-химия получения и обработки высокотемпературных материалов

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-1: Способен к поиску новых направлений научных исследований и синтезу знаний в области материаловедения и технологии материалов, способен оформлять технические задания и отчетные материалы по планируемым и проведенным исследованиям

Знать:

ПК-1-31 основные принципы обработки результатов исследования и анализа научно-технической информации

ПК-2: Способен к поиску и выбору сферы применения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Знать:

ПК-2-31 - правила безопасной работы с источниками рентгеновского и нейтронного излучения, общие нормы радиационной безопасности;

ПК-2-32 - правила безопасности работы на электронных микроскопах (просвечивающий, сканирующий, атомно-силовой)

ОПК-5: Способен решать научно-исследовательские задачи при осуществлении профессиональной деятельности с применением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области

Знать:

ОПК-5-33 основные методы исследования материалов в различных состояниях;

ОПК-5-31 физику рентгеновских лучей, законы рассеяния электроном, атомом, кристаллом, особенности дифракции рентгеновских лучей, электронов и нейтронов на кристалле;

ОПК-5-32 - принципы формирования контраста в просвечивающей и растровой электронной микроскопии

ПК-2: Способен к поиску и выбору сферы применения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Уметь:

ПК-2-У1 формировать и аргументировать собственные суждения и научную позицию, научным и техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности

ПК-1: Способен к поиску новых направлений научных исследований и синтезу знаний в области материаловедения и технологии материалов, способен оформлять технические задания и отчетные материалы по планируемым и проведенным исследованиям
Уметь:
ПК-1-У1 Использовать в исследованиях знания о строении и структуре материалов, о методах исследования материалов
ПК-1-У2 Самостоятельно проводить сбор данных, анализ и обобщение научно-технической информации, основных нормативных документов.
ОПК-5: Способен решать научно-исследовательские задачи при осуществлении профессиональной деятельности с применением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области
Уметь:
ОПК-5-У2 анализировать основные закономерности структурных исследований;
ОПК-5-У1 самостоятельно работать на компьютере с использованием основного набора прикладных программ и в Интернете;
ОПК-5-У3 применять полученные знания для решения материаловедческих и физических задач профессиональной деятельности при выполнении комплексных междисциплинарных исследований;
ПК-2: Способен к поиску и выбору сферы применения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Владеть:
ПК-2-В1 навыками использования методов структурного анализа и определения физических и физико-механических свойств материалов, техники проведения экспериментов и статистической обработки экспериментальных данных.
ПК-2-В2 применения методов планирования и проведения измерительных экспериментов, выбора и использования методов обработки экспериментальных данных и оценки результатов экспериментов;
ОПК-5: Способен решать научно-исследовательские задачи при осуществлении профессиональной деятельности с применением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области
Владеть:
ОПК-5-В1 математическим аппаратом и навыками использования современных подходов и методов физики, химии и экологии к описанию, анализу, теоретическому и экспериментальному исследованию и моделированию физических и химических систем, явлений и процессов в объеме, необходимом для освоения наук о материалах, фундаментальных и прикладных основ материаловедения и технологий материалов, использования в обучении и профессиональной деятельности;
ПК-1: Способен к поиску новых направлений научных исследований и синтезу знаний в области материаловедения и технологии материалов, способен оформлять технические задания и отчетные материалы по планируемым и проведенным исследованиям
Владеть:
ПК-1-В1 навыками сопоставления результатов исследований различными методами и опыт оценки полученных результатов;
ОПК-5: Способен решать научно-исследовательские задачи при осуществлении профессиональной деятельности с применением современных информационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области
Владеть:
ОПК-5-В2 навыками применения полученных знаний для обоснованного выбора метода анализа фазового и элементного состава, а также структуры и превращений материалов, в том числе определять структуру, фазовый состав и текстуру сталей и сплавов после различных видов термической и механической обработки

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполняемые работы
	Раздел 1. Физика рентгеновских лучей							

1.1	Рентгеновские лучи. Сплошной и характеристический спектры. Взаимодействие рентгеновских лучей с веществом, основной закон ослабления рентгеновских лучей. /Лек/	5	2	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.5 Л2.7Л3.1 Э3			
1.2	Устройство рентгеновских трубок и аппаратов. Выбор излучения и подбор фильтров. Счетчики рентгеновских квантов. Проверка закона ослабления рентгеновских лучей материалом. /Лаб/	5	3	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.5 Л2.7Л3.1			
1.3	Рассеяние электроном, атомом, кристаллом. Обратная решетка. Обратное пространство. Представление основных методов рентгеноструктурного анализа с помощью понятия ОР. Уравнения Лауэ и Вульф-Брегга. /Лек/	5	4	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.5 Л2.7Л3.1			
1.4	Интегральная интенсивность интерференционных максимумов. Расчет интенсивности в рамках кинематического приближения. /Лек/	5	4	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.7Л3.1			
1.5	Теоретический расчет относительной интенсивности /Лаб/	5	2	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1			
1.6	Выполнение домашнего задания "Расчет бета фильтра" /Ср/	5	1	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-У2 ПК-2-31	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.7Л3.1			Р14
1.7	Подготовка к контрольной работе №1 по теме "Физика рентгеновских лучей" /Ср/	5	2	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-У2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.5 Л2.7Л3.1		КМ1	
	Раздел 2. Рентгеноструктурный анализ							
2.1	Принципы определения кристаллической структуры по рентгенограмме поликристалла. Определение формы и размеров элементарной ячейки. Прецизионное определение периода решетки /Лек/	5	2	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.7Л3.1			

2.2	Рентгеновский фазовый анализ. /Лек/	5	4	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.5 Л2.7Л3.1 Э1			
2.3	Анализ твердых растворов: определение типа и концентрации твердого раствора, построение границы растворимости в двухком-понентной системе. Упорядоченные твердые растворы. Анализ распада пересыщенных твердых растворов. Анализ рентгенограммы закаленной стали. /Лек/	5	4	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.7Л3.1			
2.4	Анализ дефектов по уширению Р.Л. Рентгенографическое определение остаточных напряжений. Анализ процессов, происходящих при нагреве деформированных материалов. /Лек/	5	4	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1Л3.1			
2.5	Основные виды преимущественных ориентировок. Описание и анализ текстуры с помощью прямых полюсных фигур. Построение и анализ обратных полюсных фигур. /Лек/	5	4	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.5Л3.1			
2.6	Рентгеноспектральный анализ /Лек/	5	2	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У1 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.7Л3.1			
2.7	Изучение рентгеновской камеры РКСО для исследования неподвижных монокристаллов и определение ориентировки монокристалла по лауэграмме. /Лаб/	5	3	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У1 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1Л3.1			Р3
2.8	Индицирование линий дифрактограммы от поликристаллов кубической сингонии и определение периода решетки. /Лаб/	5	2	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У1 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.5Л3.1			Р4

2.9	Построение границы растворимости методом прецизионного определения периодов решетки. /Лаб/	5	2	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У1 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.7Л3.1			P5
2.10	Определение плотности и характера распределения дислокаций по уширению рентгеновских линий (метод аппроксимации). /Лаб/	5	4	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У1 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.5Л3.1			P6
2.11	Построение прямых полюсных фигур поликристалла с кристаллографический текстурой и без текстуры. /Лаб/	5	4	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У1 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.5 Л2.7Л3.1			P7
2.12	Рентгеновский дифрактометр. Определение фазы по дифрактограмме поликристалла. /Лаб/	5	2	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У1 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ОПК-5-В2 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2			
2.13	Анализ аксиальной текстуры /Лаб/	5	2	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У1 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ОПК-5-В2 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.5 Л2.7Л3.1			
2.14	Изучение работы текстур-дифрактометра. Построение прямой полюсной фигуры и анализ текстуры прокатки. /Лаб/	5	2	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У1 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ОПК-5-В2 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.2 Л2.5 Л2.7Л3.1			

2.15	Исследование субструктуры деформированного и отожженного металла по уширению рентгеновских линий. Особенности изучения тонкой структуры наноматериалов. /Лаб/	5	4	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У1 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ОПК-5-В2 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.5 Л2.7Л3.1			
2.16	Определение остаточных напряжений методом "sin ² Ψ". /Лаб/	5	2	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У1 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.5 Л2.7Л3.1			
2.17	Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабораторных работ по разделу "Рентгеноструктурный анализ" /Ср/	5	6	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-У2 ПК-2-31 ПК-2-В2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1			
2.18	Выполнение домашнего задания "Качественный фазовый анализ" /Ср/	5	4	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У1 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ОПК-5-В2 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-У2 ПК-2-В1	Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2			P15
2.19	Выполнение домашнего задания "Определение типа твердого раствора" /Ср/	5	2	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У1 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ОПК-5-В2 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-У2 ПК-2-В1	Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.4Л3.1			P16
2.20	Подготовка к контрольной работе 2 по теме "Рентгеноструктурный анализ" /Ср/	5	4	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-У2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1		КМ2	
	Раздел 3. Основы электронографии и нейтронографии							
3.1	Особенности дифракции электронов и нейтронов на кристалле. /Лек/	5	2	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.7Л3.1			
3.2	Особенности изучения структурно-фазового состояния поверхностного слоя материалов. Неразрушающий контроль с помощью дифракционных методов /Лек/	5	2	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.7Л3.1			

3.3	Определение положения водорода в структуре гидридов по нейтронограмме. /Лаб/	5	2	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У1 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.2Л2.7Л3.1			P17
3.4	Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к защите лабораторной работы по теме "Нейтронография. /Ср/	5	4	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-У2	Л1.2Л2.7Л3.1			
3.5	Подготовка к экзамену по курсу. /Ср/	5	17	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ОПК-5-В2 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-У2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.5 Л2.7Л3.1 Э1 Э2 Э3		КМ6	
	Раздел 4. Просвечивающая электронная микроскопия							
4.1	Принципиальная оптическая схема просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ). Формирование изображения в ПЭМ и основные режимы работы прибора. Разрешающая способность ПЭМ. /Лек/	6	4	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.6Л3.1			
4.2	Типы контрастов в ПЭМ (контраст на аморфных и кристаллических материалах: амплитудный и фазовый контраст). Прямое изображение кристаллической решетки. /Лек/	6	2	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.6Л3.1			
4.3	Основы кинематической теории дифракционного контраста. Контраст в изображении совершенного кристалла. Контраст на кристаллах с дефектами. Наблюдение дефектов упаковки и границ зерен. Контраст в изображении гетерогенных структур: деформационный матричный контраст, экстинкционный контраст. Контраст в изображении гетерогенных структур: ориентационный контраст, контраст типа полос смещения, контраст типа муара, абсорбционный контраст. /Лек/	6	8	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.6Л3.1			

4.4	Основы динамической теории рассеяния /Лек/	6	2	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л3.1			
4.5	Приготовление объектов и их просмотр в ПЭМ. /Лаб/	6	4	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-32 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л3.1			P18
4.6	Расчет электронограммы поликристалла. Расчет электронограммы монокристалла. /Лаб/	6	4	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-32 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л3.1			P19
4.7	Определение толщины фольги. /Лаб/	6	2	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ОПК-5-В2 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-32 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л3.1			P20
4.8	Анализ плотности дислокаций по электронно-микроскопическому изображению. /Лаб/	6	3	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ОПК-5-В2 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-32 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.6Л3.1			P21
4.9	Возможности современных микроскопов. Знакомство с устройством и работой ПЭМ. /Лаб/	6	4	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-32 ПК-2-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.6Л3.1 1 Э3			
4.10	Подготовка к лабораторным занятиям. Подготовка л защите лабораторных работ по разделу "ПЭМ" /Ср/	6	6	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-У2 ПК-2-32 ПК-2-В2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л3.1			

4.11	Подготовка к контрольной работе 1 по теме "ПЭМ" /Ср/	6	4	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ОПК-5-В2 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-У2 ПК-2-32	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л3.1		КМ3	
4.12	Выполнение домашнего задания "Построение точечной электронограммы" /Ср/	6	1	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л3.1			Р27
Раздел 5. Растровая электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ								
5.1	Принцип растровой (сканирующей) микроскопии. Принципиальная оптическая схема растрового микроскопа (РЭМ). Получение изображения. /Лек/	6	2	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-32	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.3Л3.1			
5.2	Виды контраста в РЭМ: контраст во вторичных электронах (топография поверхности), в обратно рассеянных («отраженных») электронах (неоднородность элементного состава), в характеристическом рентгеновском излучении (распределение химических элементов). Разрешение РЭМ в различных ответных сигналах. /Лек/	6	6	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.3Л3.1			
5.3	Анализ элементного состава материала в микрообъеме с помощью электронно-спектроскопических методов. Рентгеноспектральный микроанализ, качественный и количественный анализ. /Лек/	6	4	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.3Л3.1			
5.4	Приготовление объектов и их просмотр в РЭМ. /Лаб/	6	4	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-32 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.3Л3.1			Р23

5.5	Знакомство с устройством и работой РЭМ. Знакомство с устройством и работой РЭМ-микроанализатора /Лаб/	6	6	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-32 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.3Л3.1			
5.6	Подготовка к лабораторным занятиям. Подготовка к защите лабораторных работ по разделу "РЭМ" /Ср/	6	4	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-У2 ПК-2-32 ПК-2-В2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л3.1			
5.7	Выполнение домашнего задания "Микрорентгеноспектральный анализ" /Ср/	6	2	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У2 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ОПК-5-В2 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л3.1 Л3.2			P28
5.8	Подготовка к контрольной работе 2 по теме "РЭМ" /Ср/	6	4	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-У2 ПК-2-В2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л3.1		КМ4	
	Раздел 6. Атомно-силовая микроскопия							
6.1	Основные принципы формирования изображения. Увеличение, разрешение, абберации. Современное оборудование для атомно-силовой микроскопии. Возможности атомно-силовой микроскопии в исследовании структуры материалов. /Лек/	6	2	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л2.3 Л2.6 Э3			
6.2	Знакомство с устройством и работой атомно-силового микроскопа. /Лаб/	6	3	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-2-32 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1Л2.3 Э3			P25
6.3	Подготовка к лабораторной по разделу Атомно-силовая микроскопия /Ср/	6	1	ОПК-5-31 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-У2 ПК-2-32 ПК-2-В2	Л1.1Л2.6Л3.1 Э3			
	Раздел 7. Основы спектроскопических методов (ЭОС, РФЭС, ВИМС)							

7.1	Основные принципы оже-электронной спектроскопии, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и масс-спектрометрия вторичных ионов. Информационные возможности спектроскопических методов определения электронного состава. /Лек/	6	4	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л3.1			
7.2	Оже- электронная и рентгеновская фотоэлектронная спектроскопии, масс-спектрометрия вторичных ионов. /Лаб/	6	4	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-В1 ПК-2-32 ПК-2-У1 ПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л3.1			P26
7.3	Подготовка к практическому занятию по разделу. /Ср/	6	6	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-У2 ПК-2-32 ПК-2-В2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л3.1			
7.4	Подготовка к контрольной работе 3 "Применение дифракции рентгеновских лучей, тепловых нейтронов и быстрых электронов для решения материаловедческих задач". /Ср/	6	12	ОПК-5-31 ОПК-5-32 ОПК-5-33 ОПК-5-У3 ОПК-5-В1 ОПК-5-В2 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-У2 ПК-1-В1 ПК-2-В2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л3.1 Э3		КМ5	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки

Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки
КМ1	Контрольная работа 1 "Физика рентгеновских лучей"	ОПК-5-31;ОПК-5-В1;ПК-2-31	1.1. Природа и свойства рентгеновских лучей, их получение и регистрация. 1.2. Явления, сопровождающие прохождение рентгеновских лучей через вещество: ослабление, фотоэлектрическое поглощение, рассеяние. 1.3 Использование закономерностей ослабления проникающих излучений в рентгеновской и гамма-дефектоскопии.

КМ2	Контрольная работа 2 "Рентгеноструктурный анализ"	ОПК-5-31;ОПК-5-33;ПК-2-31	<p>2.1. Качественный и количественный фазовый анализ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на чем основан анализ - чувствительность и точность, факторы, определяющие чувствительность - основные методы количественного фазового анализа <p>2.2 Твердые растворы</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные типы твердых растворов - изменение в структуре материала при образовании твердого раствора - закон Вегарда - изменения на рентгенограмме при образовании твердых растворов - определение концентрации твердого раствора по рентгенограмме - рентгенографическое определение типа твердого раствора <p>2.3 Рентгеноанализ макронапряжений</p> <ul style="list-style-type: none"> - что такое макронапряжения - изменения на рентгенограмме при наличии в образце макронапряжений - рентгенографическое определение упругих деформаций в образце - метод «$\sin^2\psi$» <p>2.4 Рентгеноанализ текстур</p> <ul style="list-style-type: none"> - определение и основные виды текстур - примеры записи ориентировок - изменения на рентгенограмме при наличии в образце текстуры - прямая полюсная фигура <p>2.5 Анализ профиля рентгеновской линии</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные причины физического уширения - экспериментальное определение физического уширения - геометрическое уширение, требование к эталону
КМ3	Контрольная работа "ПЭМ"	ОПК-5-32;ОПК-5-33;ПК-2-32	<ul style="list-style-type: none"> - основные характеристики ПЭМ - Образцы для исследования в ПЭМ - основные режимы работы ПЭМ - основные задачи, решаемые просвечивающей электронной микроскопией.
КМ4	Контрольная работа "РЭМ"	ОПК-5-32;ОПК-5-33;ПК-2-32	<ul style="list-style-type: none"> - основные характеристики РЭМ - образцы для исследования в РЭМ - основные режимы работы РЭМ - основные задачи, решаемые растровой электронной микроскопией.
КМ5	Контрольная работа "Применение дифракции рентгеновских лучей, тепловых нейтронов и быстрых электронов для решения материаловедческих задач"	ОПК-5-31;ОПК-5-32;ОПК-5-33;ОПК-5-У2;ОПК-5-У3;ОПК-5-В1;ПК-2-31;ПК-1-31;ПК-1-У2	<ul style="list-style-type: none"> - сравнительная характеристика рентгеновской и электронной дифракции - изучение дендритной ликвации и химической неоднородности - исследование причин коррозии труб из теплостойкой стали. - комплексное исследование многослойного покрытия. - Изучение композиционного материала. - Определение кристаллической структуры соединения Me (H, N,C) - Особенности изучения структурно-фазового состояния поверхностного слоя материалов. - Неразрушающий контроль с помощью дифракционных методов.

КМ6	Экзамен	ОПК-5-31;ОПК-5-33;ОПК-5-У1;ОПК-5-У2;ОПК-5-У3;ОПК-5-В1;ОПК-5-В2;ПК-2-31;ПК-2-32;ПК-2-У1;ПК-2-В1;ПК-2-В2;ПК-1-31;ПК-1-У1;ПК-1-У2;ПК-1-В1;ОПК-5-32	<p>Рентгеновские лучи. Сплошной и характеристический спектры. (Задача: Изобразить вид спектров, испускаемых рентгеновской трубкой при различных ускоряющих напряжениях)</p> <p>Взаимодействие рентгеновских лучей с веществом, основной закон ослабления рентгеновских лучей.</p> <p>Рассеяние электроном, атомом, кристаллом.</p> <p>Обратная решетка. Обратное пространство. (Задача: По нулевой плоской сетки обратной решетки кубического кристалла определить индексы узлов, индексы оси зоны)</p> <p>Представление основных методов рентгеноструктурного анализа с помощью понятия ОР.</p> <p>Уравнения Лауэ и Вульф-Брегга.</p> <p>Интенсивность рентгеновских максимумов. Множители интенсивности. (Задача: Теоретический расчет относительной интенсивности)</p> <p>Принципы определения кристаллической структуры по рентгенограмме поликристалла. Определение формы и размеров элементарной ячейки. (Задача: Индексирование линий дифрактограммы от поликристаллов кубической сингонии и определение периода решетки)</p> <p>Прецизионное определение периода решетки</p> <p>Фазовый рентгеноструктурный анализ (качественный и количественный) Факторы, определяющие чувствительность. (Задача: Определение вещества по дифрактограмме поликристалла)</p> <p>Анализ твердых растворов: определение типа и концентрации твердого раствора.</p> <p>(Задача: определение типа твердого раствора, определение концентрации растворенного компонента)</p> <p>Построение границы растворимости в двухкомпонентной системе.</p> <p>Упорядоченные твердые растворы. Рентгенографическое определение степени дальнего порядка.</p> <p>Анализ распада пересыщенных твердых растворов.</p> <p>Анализ рентгенограммы закаленной стали.</p> <p>Анализ дефектов по уширению Р.Л. (Задача: Определение плотности и характера распределения дислокаций по уширению рентгеновских линий)</p> <p>Рентгенографическое определение остаточных напряжений. Метод "sin²Ψ".</p> <p>Основные виды преимущественных ориентировок. Описание и анализ текстуры с помощью прямых полюсных фигур. (Задача: Построение прямой полюсной фигуры и анализ по ней ограниченной текстуры). Построение и анализ обратных полюсных фигур.</p> <p>Особенности дифракции электронов и нейтронов на кристалле.</p> <p>Нейтроннография: получение нейтронограмм, основные области применения.</p> <p>Электронография: получение и расчет электронограмм, основные области применения электронографии.</p>
-----	---------	---	---

5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)

Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы
Р1	Устройство рентгеновских трубок и аппаратов. Выбор излучения и подбор фильтров. Счетчики рентгеновских квантов. Проверка закона ослабления рентгеновских лучей материалом.	ОПК-5-31;ПК-2-31	Строение и принципы работы рентгеновской трубки. Расчет толщины фольги.

P2	Теоретический расчет относительной интенсивности	ОПК-5-31;ОПК-5-В1;ПК-2-31;ПК-1-31	Использование кинематической теории для расчета теоретической интенсивности
P3	Изучение рентгеновской камеры РКСО для исследования неподвижных монокристаллов и определение ориентировки монокристалла по лауэграмме. /Лаб/	ОПК-5-31;ОПК-5-В1;ОПК-5-33;ПК-2-31;ПК-1-31	Определение ориентировки кристалла по Лауэграмме.
P4	2.8 Индексирование линий дифрактограммы от поликристаллов кубической сингонии и определение периода решетки. /Лаб/	ОПК-5-31;ОПК-5-33;ОПК-5-У1;ОПК-5-У2;ПК-2-31	Расчет дифрактограммы кубического кристалла
P5	Построение границы растворимости методом прецизионного определения периодов решетки. /Лаб/	ОПК-5-31;ОПК-5-33;ОПК-5-У2;ОПК-5-В1;ПК-2-31;ПК-1-31	Построение линии ограниченной растворимости.
P6	Определение плотности и характера распределения дислокаций по уширению рентгеновских линий (метод аппроксимации). /Лаб/	ОПК-5-31;ОПК-5-33;ОПК-5-У2;ПК-2-31;ПК-1-31	По ширине рентгеновской линии определить характер распределения дислокаций и рассчитать плотность.
P7	Построение прямых полюсных фигур поликристалла с кристаллографической текстурой и без текстуры. /Лаб/	ОПК-5-31;ОПК-5-33;ПК-2-31;ПК-1-31	Построение ППФ
P8	Рентгеновский дифрактометр. Определение фазы по дифрактограмме поликристалла.	ОПК-5-31;ОПК-5-33;ОПК-5-У1;ОПК-5-У2;ОПК-5-У3;ОПК-5-В1;ПК-2-31;ПК-2-У1;ПК-2-В2;ПК-1-У2;ПК-1-31	Расчет дифрактограммы поликристалла.
P9	Анализ аксиальной текстуры	ПК-2-31;ПК-2-У1;ПК-1-31;ОПК-5-32;ОПК-5-33	Определение текстуры волочения

P10	Изучение работы текстур-дифрактометра. Построение прямой полусной фигуры и анализ текстуры прокатки.	ОПК-5-31;ОПК-5-33;ПК-2-31;ПК-1-31;ПК-1-У1	
P11	Исследование субструктуры деформированного и отожженного металла по уширению рентгеновских линий. Особенности изучения тонкой структуры наноматериалов.	ОПК-5-31;ОПК-5-33;ОПК-5-В1;ПК-1-31;ПК-1-У2	Решение задач
P12	Определение остаточных напряжений методом "sin ² Ψ".	ОПК-5-33;ОПК-5-У2;ОПК-5-В1	
P13	Домашнее задание "Повторение кристаллографии"	ОПК-5-В1	Решение задач по кристаллографии
P14	Домашнее задание "Расчет бета фильтра"	ОПК-5-31;ОПК-5-В1;ПК-2-31;ПК-1-31;ПК-1-У2	Для заданного излучения подобрать бета фильтр необходимой кратностью ослабления.
P15	Домашнее задание "Качественный фазовый анализ"	ОПК-5-31;ОПК-5-33;ОПК-5-У1;ОПК-5-У3;ОПК-5-В1	По дифрактограмме, снятой от поликристалла проовести РФА (рентгенофозовый анализ)
P16	Домашнее задание "Определение типа твердого раствора"	ОПК-5-33;ОПК-5-В1	По изменению периода решетки определить тип твердого раствора в двух компонентой системе.
P17	Определение положения водорода в структуре гидридов по нейтронограмме	ОПК-5-31;ПК-2-31;ПК-2-У1;ПК-1-31	Расчет нейтронограммы.
P18	Приготовление объектов и их просмотр в ПЭМ. /Лаб/	ОПК-5-32;ОПК-5-33;ПК-2-32;ПК-1-31	
P19	Расчет электронограммы поликристалла. Расчет электронограммы монокристалла. /Лаб/	ОПК-5-32;ОПК-5-В1;ПК-2-32;ПК-1-31;ПК-1-У1	Расчет электронограмм, снятых от поли- и монокристаллов.
P20	Определение толщины фольги. /Лаб/	ОПК-5-32;ОПК-5-В1	По изображению дефекта упаковки определить толщину фольги.
P21	Анализ плотности дислокаций по электронно-микроскопическом у изображению. /Лаб/	ОПК-5-32;ОПК-5-В1	Определение плотности дислокаций по изображению, полученному в ПЭМ

P22	Возможности современных микроскопов. Знакомство с устройством и работой ПЭМ.	ОПК-5-32;ПК-2-32	
P23	Приготовление объектов и их просмотр в РЭМ. /Лаб/	ОПК-5-31;ОПК-5-32	
P24	Знакомство с устройством и работой РЭМ. Знакомство с устройством и работой РЭМ-микроанализатора	ОПК-5-32;ПК-2-32;ПК-1-31;ПК-1-У2	
P25	Знакомство с устройством и работой атомно-силового микроскопа.	ОПК-5-32;ПК-2-32	
P26	Оже- электронная и рентгеновская фотоэлектронная спектроскопии, масс-спектрометрия вторичных ионов.	ОПК-5-32;ПК-2-32;ПК-1-31;ПК-1-В1	Знакомство со спектроскопическими методами исследования материалов и спавов.
P27	Домашнее задание "Построение теоретической электронограммы"	ОПК-5-32;ОПК-5-В1;ПК-1-31;ПК-1-В1	Для монокристалла известной фазы построить точечную электронограмму с заданной осью зоны.
P28	Домашнее задание "Микрорентгено спектральный анализ"	ОПК-5-31;ОПК-5-У1;ОПК-5-У3;ОПК-5-В1;ПК-2-31;ПК-2-32;ПК-2-У1;ПК-1-31;ПК-1-В1	По данным, полученным в микроанализаторе определить химический состав образца. и рассчитать количество каждого из элементов.

5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

В 5 семестре предусмотрен экзамен, проходящий в письменной форме.

Экзаменационный билет состоит из задач.

Макет экзаменационного билета приведен в приложении.

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

По курсу предусмотрен в 5 семестре экзамен, в 6 семестре предусмотрен зачет с оценкой. Зачет с оценкой проставляется на основе оценок текущего контроля. Обучающийся должен выполнить все практические и самостоятельные работы, указанные в данном разделе.

Шкала оценивания знаний обучающихся:

Оценка «отлично»

– обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу.

Оценка «хорошо»

– обучающийся показывает твердые и достаточно полные знания в объеме пройденной программы, допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильно действует по применению знаний на практике, четко излагает материал.

Оценка «удовлетворительно»

– обучающийся показывает знания в объеме пройденной программы, ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно справляемыми после дополнительных и наводящих вопросов, правильно действует по применению знаний на практике.

Оценка «неудовлетворительно»

– обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные или некорректные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

Оценка «неявка» студент не явился на экзамен (на контрольные мероприятия в семестре).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**6.1. Рекомендуемая литература****6.1.1. Основная литература**

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.1	Портной В. К., Новиков А. И., Головин И. С.	Дефекты кристаллического строения металлов и методы их анализа: учебник	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2015
Л1.2	Уманский Я. С., Скаков Ю. А., Иванов А. Н., Расторгуев Л. Н.	Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия: Учебник для вузов	Библиотека МИСиС	М.: Metallurgia, 1982
Л1.3	Горелик С. С., Скаков Ю. А., Расторгуев Л. Н.	Рентгенографический и электронно-оптический анализ: учеб. пособие для вузов	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2002
Л1.4	Горелик С. С., Скаков Ю. А., Расторгуев Л. Н.	Рентгенографический и электронно-оптический анализ: Учеб. пособие для вузов	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 1994

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.1	Жданов Г. С., Уманский Я. С.	Рентгенография металлов	Электронная библиотека	Москва, Ленинград: Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии, 1941
Л2.2	Миркин Л. И., Уманский Я. С.	Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов: справочник	Электронная библиотека	Москва: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961
Л2.3	Домкин К. И.	Растровая электронная микроскопия для нанотехнологий: методы и применение: монография	Электронная библиотека	Москва: Лаборатория знаний, 2017

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.4	Захаров А. М.	Диаграммы состояния двойных и тройных систем: учеб. пособие для студ. металлург. и машиностроит. спец. вузов	Библиотека МИСиС	М.: Металлургия, 1990
Л2.5	Новиков И. И., Строганов Г. Б., Новиков А. И.	Металловедение, термообработка и рентгенография: Учебник для студ. металлург. и машиностроит. спец. вузов	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 1994
Л2.6	Брандон Д., Каплан У., Баженов С. Л., Егорова С. В.	Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля: учеб. пособие для студ. напр. 'Прикладные математика и физика': пер. с англ.	Библиотека МИСиС	М.: Техносфера, 2004
Л2.7	Уманский Я. С.	Рентгенография металлов и полупроводников: учеб. пособие для студ. металлург. спец. вузов	Библиотека МИСиС	М.: Металлургия, 1969

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л3.1	Векилова Галина Владимировна, Иванов А. Н., Ягодкин Юрий Дмитриевич	Дифракционные и микроскопические методы и приборы для анализа наночастиц и наноматериалов: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 'Металлургия'	Электронная библиотека	М.: [МИСиС], 2009
Л3.2	Дьяконова Н. П., Иванов А. Н.	Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия: Разд.: Микрорентгеноспектральный анализ: метод. указания для выполнения дом. заданий 'Расчет концентраций элементов по данным MAP' для студ. спец. 11.01, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.10, 11.04а	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 1991

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Э1	International Centre for Diffraction Data	http://www.icdd.com/
Э2	Inorganic Crystal Structure Database:	https://p1.misis.ru:5019/RPD/Index/1685435/%20http://www.fiz-karlsruhe.de/icsd.html
Э3	Научная электронная библиотека eLIBRARY	http://elibrary.ru/

6.3 Перечень программного обеспечения

П.1	Лицензии ПО Windows Server CAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL, ПО WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr и PerUsr
П.2	Microsoft Office
П.3	LMS Canvas
П.4	MS Teams
П.5	ESET NOD32 Antivirus

6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных

И.1	наукометрическая система InCites https://apps.webofknowledge.com
И.2	Springer materials https://materials.springer.com/
И.3	International Centre for Diffraction Data http://www.icdd.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ауд.	Назначение	Оснащение
------	------------	-----------

Б-413	Учебная аудитория	проектор; мультимедийная доска; маркерная доска, документ-камера; компьютер преподавателя; компьютерный класс на 14 компьютеров, пакет лицензионных программ MS Office, комплект учебной мебели
Б-016	Международная школа микроскопии:	просвечивающий электронный микроскоп JEOL JEM-1400 (STEM conf.); сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM-IT500LA (+JEOL EDS); атомно-силовой микроскоп AIST-NT SmartSPM-1000 (AFM, MFM, SPM); комплекс пробоподготовки в составе: JEOL IonSlicer-9100IS; Struers Tenupol-5 с криостатом; Struers Lectropol-5 с криостатом. Зал на 11 рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами с подключением сети "Интернет" и электронной информационно-образовательной среде университета, пакет лицензионных программ MS Office, комплект учебной мебели, проектор (2 шт), интерактивная доска, экран
Любой корпус Мультимедийная	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и/или для проведения практических занятий:	комплект учебной мебели до 36 мест для обучающихся, мультимедийное оборудование, магнитно-маркерная доска, рабочее место преподавателя, ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus
Читальный зал электронных ресурсов		комплект учебной мебели на 55 мест для обучающихся, 50 ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus.
Б-413	Учебная аудитория	проектор; мультимедийная доска; маркерная доска, документ-камера; компьютер преподавателя; компьютерный класс на 14 компьютеров, пакет лицензионных программ MS Office, комплект учебной мебели

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

При изучении курса материалы» большое внимание следует уделить самостоятельной работе с учебниками, справочной литературой и текущими публикациями в ведущих российских и зарубежных журналах по рассматриваемым темам курса. Большую часть вопросов, возникающих в процессе самостоятельной подготовки, рекомендуется выносить для обсуждения на практических занятиях.

Обучение проводится в два семестра и организуется в соответствии с настоящей программой. Самостоятельная работа студентов осуществляется и контролируется с помощью:

- вопросов для самоконтроля,
- контрольных работ,
- домашних заданий.

Контрольные работы проводятся в часы практических занятий.

Контрольные работы оцениваются по пятибалльной системе, домашние задания по двухбалльной.

Перед началом занятий студенты получают на текущий семестр календарный план проведения лабораторных работ, практических занятий и контрольных работ, график выдачи и сдачи домашних заданий.

Для успешного освоения изучаемой дисциплины для студентов организуются еженедельные консультации преподавателей.